



Linko Semiconductor Co., Ltd.
南京凌鸥创芯电子有限公司

LKS32HD303M6S8C

32bit Compact MCU for Motor Control

特性

- 48MHz 32 位 Cortex-M0 内核，硬件除法协处理器
- 低功耗休眠模式，MCU 休眠功耗 30uA
- -40~105°C 工业级工作温度范围
- 2.5V~5.5V 单电源供电，内部集成数字供电 LDO
- 超强抗静电和群脉冲能力

存储

- 16kB flash/16kB flash+16kB ROM/32kB flash 三种规格，带 flash 防窃密功能
- 4kB RAM

时钟

- 内置 4MHz 高精度 RC 时钟，全温度范围精度 $\pm 1\%$
- 内置 64kHz 低速时钟，供低功耗模式使用
- 内部 PLL 可提供最高 48MHz 时钟

外设

- 一路 UART
- 一路 SPI
- 一路 IIC
- 通用 16/32 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM
- 电机控制专用 PWM 模块，支持 6 路 PWM 输出，独立死区控制
- Hall 信号专用接口，支持测速、去抖
- 4 通道 DMA
- 硬件看门狗
- 最多支持 25 路 GPIO

模拟模块

- 集成 1 路 12bit SAR ADC，1.2Msps 采样及转换速率，共 11 通道
- 集成 2 路 OPA，可设置为差分 PGA 模式
- 集成两路比较器
- 集成 8bit DAC 数模转换器，作为内部比较器输入
- 内置 1.2V 0.5%精度电压基准源
- 内置 1 路低功耗 LDO 和电源监测电路
- 集成高精度、低温漂高频 RC 时钟

主要优势

- ◇ 内部集成 2 路高速运放，可满足单电阻/双电阻电流采样拓扑架构的不同需求
- ◇ 运放输入端口集成电压钳位保护电路，只需要外加两个限流电阻就可实现 MOSFET 内阻直接电流采样
- ◇ ADC 模块变增益技术，可以和高速运放配合，处理更宽的电流动态范围，兼顾小电流和大电流的采样精度
- ◇ 集成两路比较器
- ◇ ESD 及抗干扰能力强，稳定可靠
- ◇ 单电源 2.5V~5.5V 供电，确保了系统供电的通用性
- ◇ 高集成度、体积小、节约 BOM 成本
- ◇ 支持 IEC/UL60730 功能安全认证

应用场景

适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。适用数字电源控制系统。



1 概述

1.1 功能简述

LKS32HD303M6S8C 是 32 位内核的面向电机控制应用的紧凑型专用处理器，集成了常用电机控制系统所需要的所有模块。

- 性能

- 48MHz 32 位 Cortex-M0 内核
- 低功耗休眠模式
- 集成三相全桥自举式栅极驱动模块
- 工业级工作温度范围
- 超强抗静电和群脉冲能力

- 存储器

- 32kB Flash，带加密功能，带 128 位芯片唯一识别码
- 4kB RAM

- 工作范围

- 采用 2.5V~5.5V 电源供电,内部集成 1 个 LDO，为数字部分电路供电。
- 工作温度: -40~105°C

- 时钟

- 内置 4MHz 高精度 RC 时钟，-40~105°C 范围内精度在±1%之内
- 内置低速 64kHz 低速时钟，供低功耗模式使用
- 内部 PLL 可提供最高 48MHz 时钟

- 外设模块

- 一路 UART
- 一路 SPI，支持主从模式
- 一路 IIC，支持主从模式
- 1 个通用 16 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM 功能
- 1 个通用 32 位 Timer，支持捕捉和边沿对齐 PWM 功能
- 电机控制专用 PWM 模块，支持 8 路 PWM 输出，独立死区控制
- Hall 信号专用接口，支持测速、去抖功能



- 硬件看门狗
- 25 路 GPIO。8 个 GPIO 可以作为系统的唤醒源。17 个 GPIO 可以用作外部中断源输入

- 模拟模块

- 集成 1 路 12bit SAR ADC，1.2Mps 采样及转换速率，共 11 通道
- 集成 2 通道运算放大器，可设置为差分 PGA 模式
- 集成两路比较器
- 集成 8bit DAC 数模转换器
- 内置 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 温度传感器
- 内置 1.2V 0.5%精度电压基准源
- 内置 1 路低功耗 LDO 和电源监测电路
- 集成高精度、低温飘高频 RC 时钟

1.2 主要优势

- 高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约 BOM 成本。
- 内部集成 2 通道高速运放和两路比较器，可满足单电阻/双电阻电流采样拓扑架构的不同需求；
- 内部高速运放集成高压保护电路，可以允许高电平共模信号直接输入芯片，可以用最简单的电路拓扑实现 MOSFET 电阻直接电流采样模式；
- 应用专利技术使 ADC 和高速运放达到最佳配合，可处理更宽的电流动态范围，同时兼顾高速小电流和低速大电流的采样精度；
- 整体控制电路简洁高效，抗干扰能力强，稳定可靠；
- 集成三相全桥自举式栅极驱动模块；

适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。

1.3 系统资源

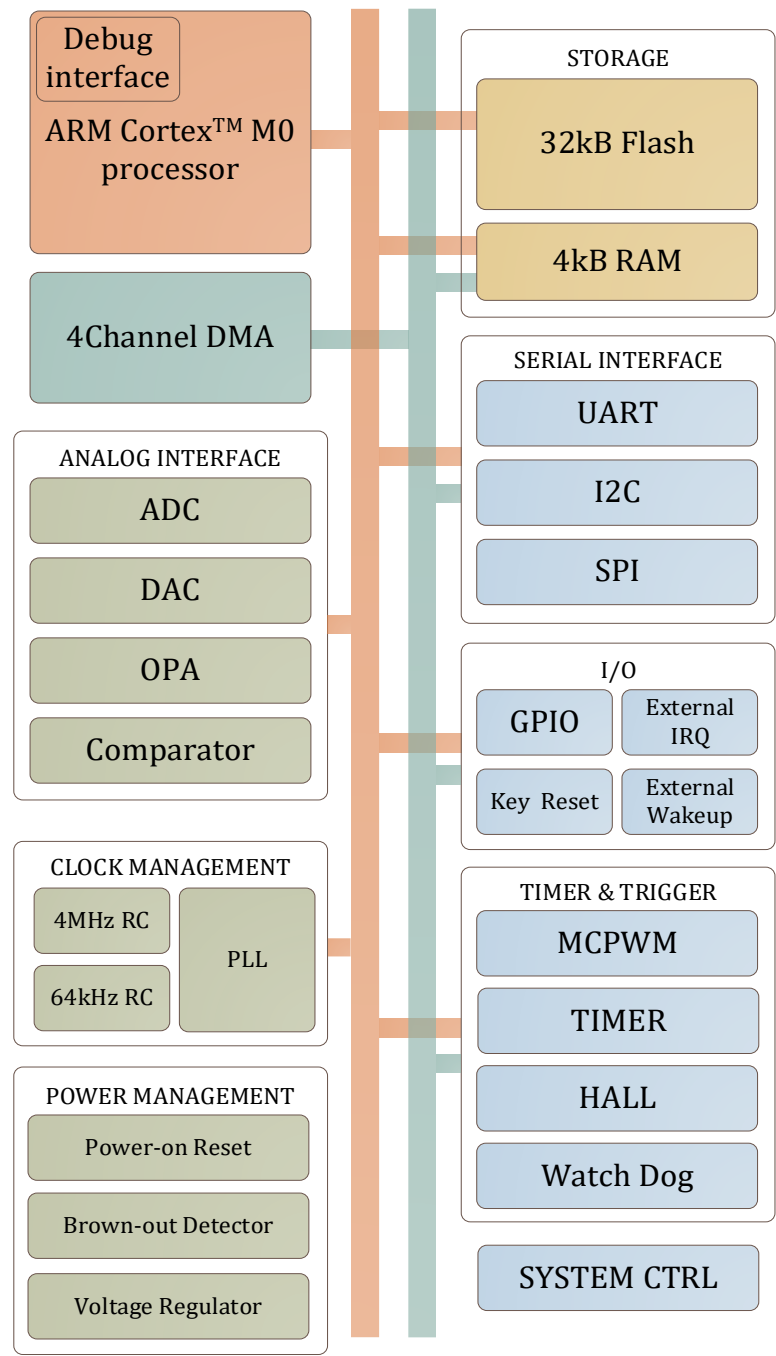


图 1-1 LKS32HD303M6S8C 系统框图



1.4 矢量正弦控制系统

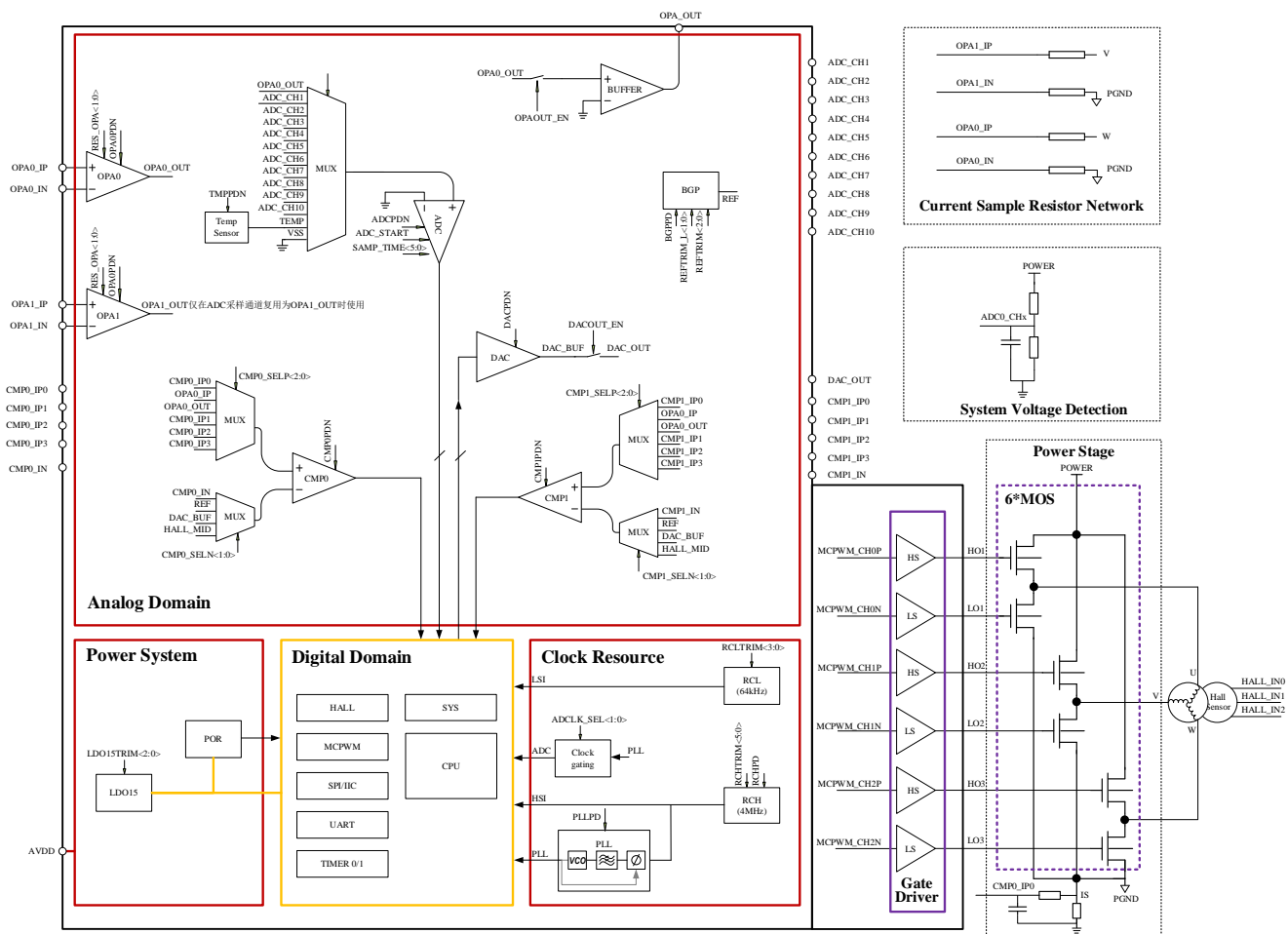


图 1-2 LKS32HD303M6S8C 矢量正弦控制系统简化原理图

2 管脚分布

2.1 管脚分布图及管脚说明

2.1.1 特别说明

PU 为 Pull-Up 的缩写，下列引脚图中 PU 引脚内置上拉至 AVDD 的电阻：

RSTN 引脚内置 100k Ω 上拉电阻，固定开启上拉，当 RSTN 功能切换为 GPIO 功能后，上拉可以关闭。

SWDIO/SWCLK 内置 10k Ω 上拉电阻，固定开启上拉，当 SWD 功能切换为 GPIO 功能后，上拉可以关闭。

其余红色 PU 引脚内置 10k Ω 上拉电阻，可软件控制开启关闭上拉。

EXTI 引脚为外部中断/GPIO 中断

UARTx_TX(RX): UART 的 TX 和 RX 支持互换。当 GPIO 第二功能选择为 UART，且 GPIO_PIE 即输入使能时，可以作为 UART_RX 使用；当 GPIO_POE 使能时，可以作为 UART_TX 使用。一般同一 GPIO 不同时使能输入和输出，否则输入 PDI 会接收到 PDO 发出的数据。

SPI_DI(DO): SPI 的 DI 和 DO 支持互换，当 GPIO 第二功能选择为 SPI，且 GPIO_PIE 即输入使能时，可以作为 SPI_DI 使用；当 GPIO_POE 即输出使能时，可以作为 SPI_DO 使用。一般同一 GPIO 不同时使能输入和输出，否则输入 PDI 会接收到 PDO 发出的数据。

2.1.2 LKS32HD303M6S8C -For high-speed air blower only

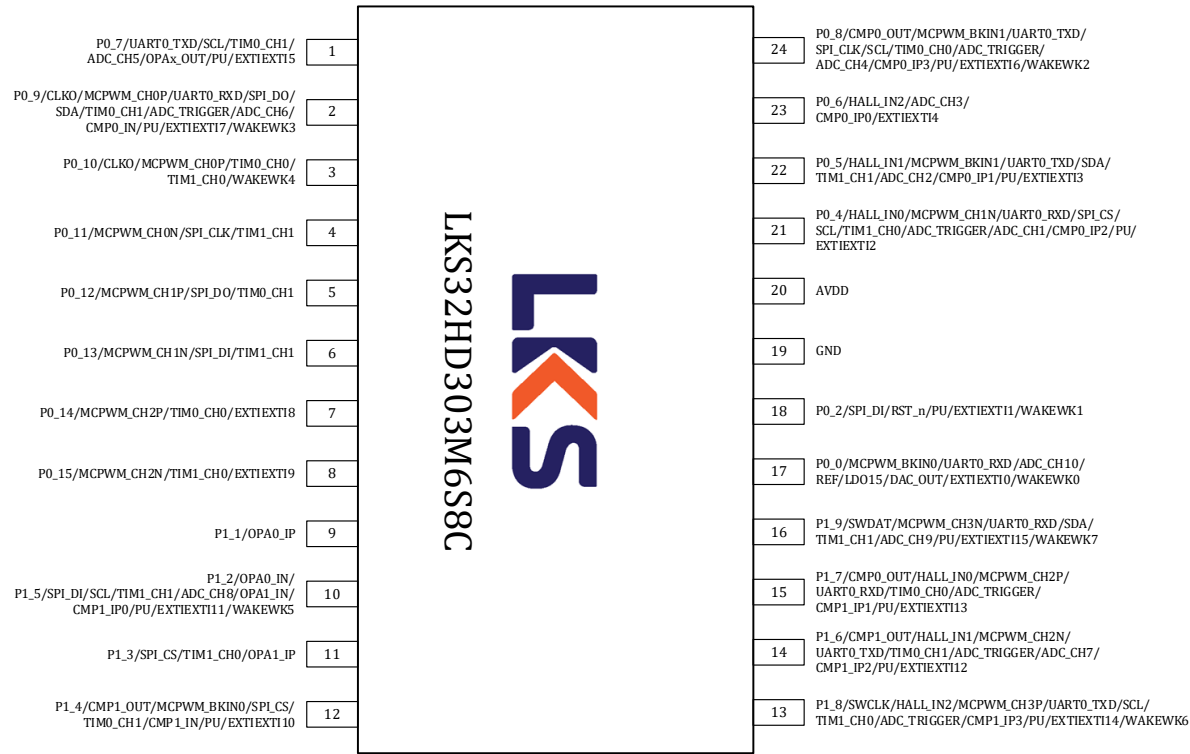


图 2-1 LKS32HD303M6S8C 管脚分布图

表 2-1 LKS32HD303M6S8C 管脚说明

1	P0_7	P0.7
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SCL	I2C 时钟
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	ADC_CH5	ADC 通道 5
	OPA _x _OUT	运放输出
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻，软件可关闭
	EXTI5	外部 GPIO 中断信号 5
2	P0_9	P0.9
	CLKO	时钟输出(用于调试)
	MCPWM_CH0P	PWM 通道 0 高边
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	SPI_DO	SPI 数据输出(输入)
	SDA	I2C 数据
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	ADC_TRIGGER	ADC 触发信号输出(用于调试)
	ADC_CH6	ADC 通道 6
	CMP0_IN	比较器 0 负端输入
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻，软件可关闭



	EXTI7	外部 GPIO 中断信号 7
	WK3	外部唤醒信号 3
3	P0_10	P0.10
	CLKO	时钟输出(用于调试)
	MCPWM_CH0P	PWM 通道 0 高边
	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	WK4	外部唤醒信号 4
4	P0_11	P0.11
	MCPWM_CH0N	PWM 通道 0 低边
	SPI_CLK	SPI 时钟
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
5	P0_12	P0.12
	MCPWM_CH1P	PWM 通道 1 高边
	SPI_DO	SPI 数据输出(输入)
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
6	P0_13	P0.13
	MCPWM_CH1N	PWM 通道 1 低边
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
7	P0_14	P0.14
	MCPWM_CH2P	PWM 通道 2 高边
	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	EXTI8	外部 GPIO 中断信号 8
8	P0_15	P0.15
	MCPWM_CH2N	PWM 通道 2 低边
	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	EXTI9	外部 GPIO 中断信号 9
9	P1_1	P1.1
	OPA0_IP	运放 0 正端输入
10	P1_2	P1.2
	OPA0_IN	运放 0 负端输入
	P1_5	P1.5
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	SCL	I2C 时钟
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
	ADC_CH8	ADC 通道 8
	OPA1_IN	运放 1 负端输入
	CMP1_IP0	比较器 1 正端输入 0
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI11	外部 GPIO 中断信号 11
	WK5	外部唤醒信号 5
11	P1_3	P1.3

	SPI_CS	SPI 片选
	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	OPA1_IP	运放 1 正端输入
12	P1_4	P1.4
	CMP1_OUT	比较器 1 输出
	MCPWM_BKIN0	PWM 停机输入信号 0
	SPI_CS	SPI 片选
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	CMP1_IN	比较器 1 负端输入
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI10	外部 GPIO 中断信号 10
13	P1_8	P1.8
	SWCLK	SWD 时钟
	HALL_IN2	HALL 接口输入 2
	MCPWM_CH3P	PWM 通道 3 高边
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SCL	I2C 时钟
	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	ADC_TRIGGER	ADC 触发信号输出(用于调试)
	CMP1_IP3	比较器 1 正端输入 3
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI14	外部 GPIO 中断信号 14
	WK6	外部唤醒信号 6
14	P1_6	P1.6
	CMP1_OUT	比较器 1 输出
	HALL_IN1	HALL 接口输入 1
	MCPWM_CH2N	PWM 通道 2 低边
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	TIM0_CH1	Timer0 通道 1
	ADC_TRIGGER	ADC 触发信号输出(用于调试)
	ADC_CH7	ADC 通道 7
	CMP1_IP2	比较器 1 正端输入 2
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI12	外部 GPIO 中断信号 12
15	P1_7	P1.7
	CMP0_OUT	比较器 0 输出
	HALL_IN0	HALL 接口输入 0
	MCPWM_CH2P	PWM 通道 2 高边
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	ADC_TRIGGER	ADC 触发信号输出(用于调试)
	CMP1_IP1	比较器 1 正端输入 1
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭

	EXTI13	外部 GPIO 中断信号 13
16	P1_9	P1.9
	SWDAT	SWD 数据
	MCPWM_CH3N	PWM 通道 3 低边
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	SDA	I2C 数据
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
	ADC_CH9	ADC 通道 9
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI15	外部 GPIO 中断信号 15
	WK7	外部唤醒信号 7
17	P0_0	P0.0
	MCPWM_BKIN0	PWM 停机输入信号 0
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	ADC_CH10	ADC 通道 10
	REF	参考电压
	LD015	1.5V LDO 输出
	DAC_OUT	DAC 输出
	EXTI0	外部 GPIO 中断信号 10
	WK0	外部唤醒信号 0
18	P0_2	P0.2
	SPI_DI	SPI 数据输入(输出)
	RST_n	复位引脚, P0.2 默认用作 RSTN。建议接一个 10nF~100nF 的电容到地, 并在 RSTN 和 AVDD 之间放置一个 10k~20k 的上拉电阻。如果外部有上拉电阻, RSTN 的电容应为 100nF。P0.2 可切换为 GPIO, 切换后可关闭 10kΩ 上拉电阻。
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI1	外部 GPIO 中断信号 1
	WK1	外部唤醒信号 1
19	GND	芯片地, 强烈建议多个地引脚在 PCB 上统一接地
20	AVDD	MCU 电源
21	P0_4	P0.4
	HALL_IN0	HALL 接口输入 0
	MCPWM_CH1N	PWM 通道 1 低边
	UART0_RXD	串口 0 接收(发送)
	SPI_CS	SPI 片选
	SCL	I2C 时钟
	TIM1_CH0	Timer1 通道 0
	ADC_TRIGGER	ADC 触发信号输出(用于调试)
	ADC_CH1	ADC 通道 1
	CMP0_IP2	比较器 0 正端输入 2
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI2	外部 GPIO 中断信号 2
22	P0_5	P0.5

	HALL_IN1	HALL 接口输入 1
	MCPWM_BKIN1	PWM 停机输入信号 1
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SDA	I2C 数据
	TIM1_CH1	Timer1 通道 1
	ADC_CH2	ADC 通道 2
	CMP0_IP1	比较器 0 正端输入 1
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI3	外部 GPIO 中断信号 3
23	P0_6	P0.6
	HALL_IN2	HALL 接口输入 2
	ADC_CH3	ADC 通道 3
	CMP0_IP0	比较器 0 正端输入 0
	EXTI4	外部 GPIO 中断信号 4
24	P0_8	P0.8
	CMP0_OUT	比较器 0 输出
	MCPWM_BKIN1	PWM 停机输入信号 1
	UART0_TXD	串口 0 发送(接收)
	SPI_CLK	SPI 时钟
	SCL	I2C 时钟
	TIM0_CH0	Timer0 通道 0
	ADC_TRIGGER	ADC 触发信号输出(用于调试)
	ADC_CH4	ADC 通道 4
	CMP0_IP3	比较器 0 正端输入 3
	PU	内置 10kΩ 上拉电阻, 软件可关闭
	EXTI6	外部 GPIO 中断信号 6
	WK2	外部唤醒信号 2

2.2 引脚复用

表 2-2 LKS32HD303M6S8C 引脚功能选择

Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF0
P0.0			MCPWM_BKIN0	UART0_R(T)XD						ADC_CH10/REF/LDO15/DAC_OUT
P0.1					SPI_CS					OPA0_IP_B
P0.2					SPI_DI(O)					RST_n
P0.3								TIM1_CH0		OPA0_IN_B
P0.4		HALL_IN0	MCPWM_CH1N	UART0_R(T)XD	SPI_CS	SCL		TIM1_CH0	ADC_TRIGGER	ADC_CH1/CMP0_IP2
P0.5		HALL_IN1	MCPWM_BKIN1	UART0_T(R)XD				TIM1_CH1		ADC_CH2/CMP0_IP1
P0.6		HALL_IN2								ADC_CH3/CMP0_IP0
P0.7				UART0_T(R)XD		SCL	TIM0_CH1			ADC_CH5/OPA _x _OUT
P0.8	CMP0_OUT		MCPWM_BKIN1	UART0_T(R)XD	SPI_CLK	SCL	TIM0_CH0		ADC_TRIGGER	ADC_CH4/CMP0_IP3
P0.9	CLKO		MCPWM_CH0P	UART0_R(T)XD	SPI_DO(I)	SDA	TIM0_CH1		ADC_TRIGGER	ADC_CH6/CMP0_IN
P0.10	CLKO		MCPWM_CH0P				TIM0_CH0	TIM1_CH0		
P0.11			MCPWM_CH0N		SPI_CLK			TIM1_CH1		
P0.12			MCPWM_CH1P		SPI_DO(I)		TIM0_CH1			
P0.13			MCPWM_CH1N		SPI_DI(O)			TIM1_CH1		
P0.14			MCPWM_CH2P				TIM0_CH0			
P0.15			MCPWM_CH2N					TIM1_CH0		



Port	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF0
P1.1										OPA0_IP
P1.2										OPA0_IN
P1.3					SPI_CS			TIM1_CH0		OPA1_IP
P1.4	CMP1_OUT				SPI_CS		TIM0_CH1			CMP1_IN
P1.5			MCPWM_BKIN0		SPI_DI(O)	SCL		TIM1_CH1		ADC_CH8/OPA1_IN/CMP1_IP0
P1.6	CMP1_OUT	HALL_IN1	MCPWM_CH2N	UART0_T(R)XD			TIM0_CH1		ADC_TRIGGER	ADC_CH7/CMP1_IP2
P1.7	CMP0_OUT	HALL_IN0	MCPWM_CH2P	UART0_R(T)XD			TIM0_CH0		ADC_TRIGGER	CMP1_IP1
P1.8	SWCLK	HALL_IN2	MCPWM_CH3P	UART0_T(R)XD		SCL		TIM1_CH0	ADC_TRIGGER	CMP1_IP3
P1.9	SWDAT		MCPWM_CH3N	UART0_R(T)XD		SDA		TIM1_CH1		ADC_CH9



3 封装尺寸

3.1 LKS32HD303M6S8C

SSOP24L:

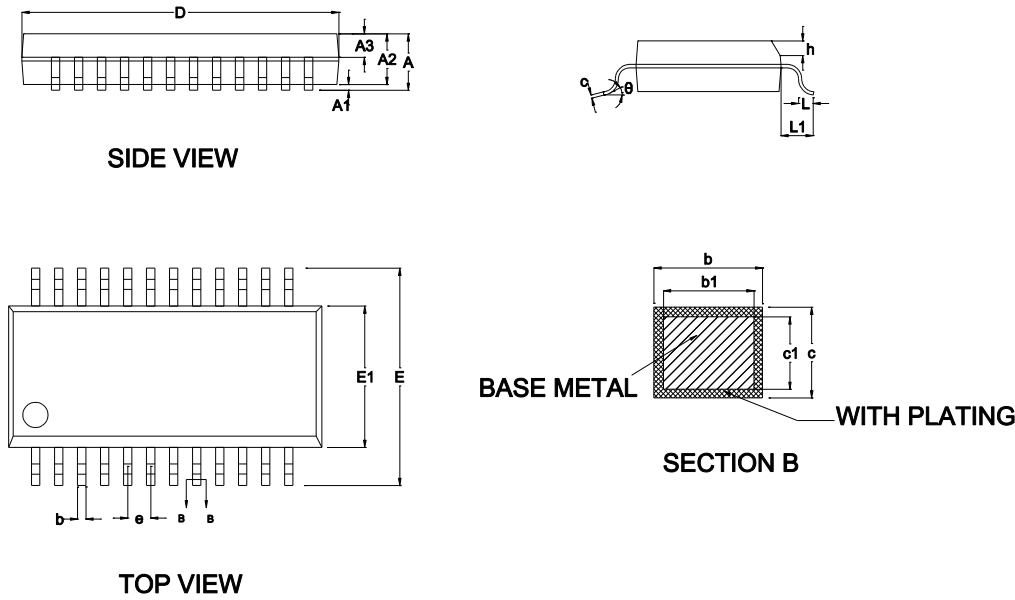


图 3-1 LKS32HD303M6S8C 封装图示

表 3-1 LKS32HD303M6S8C 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

4 电气性能参数

表 4-1 LKS32HD303M6S8C 电气极限参数

参数	最小	最大	单位	说明
MCU 电源电压(AVDD)	-0.3	+6.0	V	
工作温度	-40	+105	°C	
电源电压(VCC LDO)	-0.3	+30.0	V	LDO 供电的引脚
5V LDO 输出电流		100	mA	
存储温度	-40	+150	°C	
结温	-	125	°C	
引脚温度	-	260	°C	焊接, 10 秒

表 4-2 LKS32HD303M6S8C 建议工况参数

参数	最小	典型	最大	单位	说明
MCU 电源电压(AVDD)	2.5	5	5.5	V	
模拟工作电压(AVDD _A)	2.8	5	5.5	V	REF2VDD=0, ADC 选择 2.4V 内部基准
	2.4	5	5.5	V	REF2VDD=1, ADC 选择 AVDD 为基准
LDO 电源电压(VCC LDO)	7		20	V	LDO 供电引脚

运算放大器可以在 2.5V 下工作, 但输出幅度受限。

表 4-3 LKS32HD303M6S8C ESD 性能参数

项目	最小	最大	单位
ESD测试 (HBM)	-6000	6000	V

根据《MIL-STD-883J Method 3015.9》, 在 25°C, 55%相对湿度环境下, 在被测芯片的所有 IO 引脚施加进行静电放电 3 次, 每次间隔 1s。测试结果显示芯片抗静电放电等级达到 Class 3A $\geq 4000V$, $< 8000V$ 。

表 4-4 LKS32HD303M6S8C Latch-up 性能参数

项目	最小	最大	单位
Latch-up电流 (85°C)	-200	200	mA

根据《JEDEC STANDARD NO.78E NOVEMBER 2016》, 对所有电源 IO 施加过压 8V, 在每个信号 IO 上注入 200mA 电流。测试结果显示芯片抗钳锁等级为 200mA。

表 4-5 LKS32HD303M6S8C IO 极限参数

参数	描述	最小	最大	单位
V _{IN}	GPIO信号输入电压范围	-0.3	6.0	V
I _{INJ_PAD}	单个GPIO最大注入电流	-11.2	11.2	mA
I _{INJ_SUM}	所有GPIO最大注入电流	-50	50	mA

表 4-6 LKS32HD303M6S8C IO DC 参数

参数	描述	AVDD	条件	最小	最大	单位
----	----	------	----	----	----	----

V _{IH}	数字IO输入高电压	5V	-	0.7*AVDD		V
		3.3V		2.0		
V _{IL}	数字IO输入低电压	5V	-		0.3*AVDD	V
		3.3V			0.8	
V _{HYS}	施密特迟滞范围	5V	-	0.1*AVDD		V
		3.3V				
I _{IH}	数字IO输入高电压，电流消耗	5V	-		1	uA
		3.3V				
I _{IL}	数字IO输入低电压，电流消耗	5V	-	-1		uA
		3.3V				
V _{OH}	数字IO输出高电压		最大驱动电流 11.2mA	AVDD-0.8		V
V _{OL}	数字IO输出低电压		最大驱动电流 11.2mA		0.5	V
R _{pup}	上拉电阻大小*			8	12	kΩ
R _{io-ana}	IO与内部模拟电路间连接电阻			100	200	Ω
C _{IN}	数字IO输入电容	5V	-		10	pF
		3.3V				

*仅部分 IO 内置上拉，详见引脚说明章节

表 4-7 LKS32HD303M6S8C 电流消耗 IDDQ

主时钟	工况	3.3V	5V	单位
48MHz	开启CPU、flash、SRAM、MCPWM、Timer、以及所有模拟模块，IO不动作	8.570	8.650	mA
4MHz	开启CPU、flash、SRAM、MCPWM、Timer、以及除PLL之外的所有模拟模块，IO不动作	3.012	3.165	mA
64kHz		2.445	2.618	mA
-	深度休眠，关闭PLL，BGP等，只保留64kHz LRC	27	30	uA
-	所有模拟模块	2.4	2.55	mA

以上测试如无特别标注，均为室温 25°下测量，由于制造工艺存在器件模型偏差，不同芯片的电流消耗会存在个体差异。

5 模拟性能参数

表 5-1 LKS32HD303M6S8C 模拟性能参数

参数	最小	典型	最大	单位	说明
ADC					
工作电源	2.8	5	5.5	V	REF2VDD=0, ADC 选择 2.4V 内部基准
	2.4	5	5.5	V	REF2VDD=1, ADC 选择 AVDD 为基准
输出码率		1.2		MHz	$f_{adc}/20$
差分输入信号范围	-2.352		+2.352	V	REF2VDD=0, Gain=1; REF=2.4V
	-3.528		+3.528	V	REF2VDD=0, Gain=2/3; REF=3.6V
单端输入信号范围	-0.3		+2.352	V	REF2VDD=0, Gain=1; REF=2.4V
	-0.3		+3.528	V	REF2VDD=0, Gain=2/3; REF=3.6V
	-0.3		AVDD*0.9	V	REF2VDD=1, Gain=1; REF=AVDD
	-0.3		AVDD+0.3	V	REF2VDD=1, Gain=2/3, REF=AVDD, 受限于 IO 钳位
差分信号通常为芯片内部 OPA 输出至 ADC 的信号;单端信号通常为外部通过 IO 输入的被采样信号;无论使用内部/外部基准, ADC 测量信号幅度均不应超过满量程的 $\pm 98\%$, 特别地, 当使用外部基准时, 建议采样信号不超过量程的 90%。					
直流失调(offset)		5	10	mV	可校正
有效位数(ENOB)	10.5	11		bit	
INL		2	3	LSB	
DNL		1	2	LSB	
SNR	63	66		dB	
输入电阻	500k			Ohm	
输入电容		10pF		F	
基准电压(REF)					
工作电源	2.5	5	5.5	V	
输出偏差	-9		9	mV	
电源抑制比		70		dB	
温度系数		20		ppm/ $^{\circ}\text{C}$	
输出电压		2.4		V	
DAC					
工作电源	2.5	5	5.5	V	
负载电阻	50k			Ohm	
负载电容			50p	F	
输出电压范围	0.05		3	V	
转换速度			1M	Hz	
DNL		1	2	LSB	

参数	最小	典型	最大	单位	说明
INL		2	4	LSB	
OFFSET		5	10	mV	
SNR	57	60	66	dB	
运放(OPA)					
工作电源	3.1	5	5.5	V	
带宽		10M	20M	Hz	
负载电阻	20k			Ohm	
负载电容			5p	F	
输入共模范围	0		AVDD	V	
输出信号范围	0		2*Vcm	V	最小负载电阻下
OFFSET		10	15	mV	此 OFFSET 为 OPA 差分输入短接时，测量 OPA_OUT 偏离 0 电平，得到的等效差分输入端偏差。 OPA 输出端偏差为 OPA 放大倍数 xOFFSET
共模电平(Vcm)	1.65		2.15	V	测量条件：常温。 运 放 摆 幅 = $2 \times \min(\text{AVDD}-V_{\text{cm}}, V_{\text{cm}})$ 。建议使用 OPA 单端输出的应用上电后进行 Vcm 测量并进行软件减除校正。更多分析请参考官网应用笔记《ANN009-运放差分 and 单端工作模式区别》
共模抑制(CMRR)		80		dB	
电源抑制(PSRR)		80		dB	
负载电流			500	uA	
摆率(Slew rate)		5		V/us	
相位裕度		60		度	
比较器(CMP)					
工作电源	2.5	5	5.5	V	
输入信号范围	0		AVDD	V	
OFFSET		-12.92		mV	0mV 回差，CMP 输出低到高翻转
		-12.12		mV	0mV 回差，CMP 输出高到低翻转
		-11.63		mV	20mV 回差，CMP 输出低到高翻转
		5.21		mV	20mV 回差，CMP 输出高到低翻转
传输延时		0.15u		S	默认功耗
		0.6u		S	低功耗
回差(Hysteresis)		20		mV	HYS='0'
		0		mV	HYS='1'
GPIO					
高电平翻转阈值	2.61		3.04	V	

模拟寄存器表说明：

地址 **0x40000010~0x40000028** 是各个模块的校正寄存器，这些寄存器在出厂之前都会填上各自的校正值。一般情况下用户不要去配置或改变这些值。如果需要对模拟参数进行微调，需要读取原校正值，并以此为基础进行微调。

其中空白部分的寄存器必须全部配置为 **0**(芯片上电后会被复位为 **0**)。其他寄存器根据应用场合需要进行配置。

6 电源管理系统

6.1 AVDD 引脚电源系统

电源管理系统由 LDO15 模块、电源检测模块(PVD)、上电/掉电复位模块(POR)组成。

AVDD 为电源输入，电压范围 2.5~5.5V。片外去耦电容建议 $\geq 1\mu\text{F}$ ，并尽量靠近 AVDD 引脚。

AVDD 内部给 LDO15 模块供电，LDO15 为内部所有数字电路、PLL 模块供电。

LDO15 上电后自动开启，无需软件配置，但 LDO15 输出电压可通过软件实现微调。

LDO15 的输出电压可通过设置寄存器 LDO15TRIM<2:0>来调节，具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。LDO15 在芯片出厂前已经过校正，一般情况下，用户不需要额外配置这些寄存器。如需微调 LDO 的输出电压，需要读取原配置值，在此基础上加上微调量对应的配置值填入寄存器。

POR 模块监测 LDO15 的电压，在 LDO15 电压低于 1.1V 时(例如上电之初，或者掉电之时)，为数字电路提供复位信号以避免数字电路工作产生异常。

7 时钟系统

时钟系统包括内部 64kHz RC 时钟、内部 4MHz RC 时钟、PLL 电路组成。

64k RC 时钟作为 MCU 系统慢时钟使用,作为诸如滤波模块或者低功耗状态下的 MCU 时钟使用。

4MHz RC 时钟作为 MCU 主时钟使用,配合 PLL 可提供最高到 48MHz 的时钟。

64k 和 4M RC 时钟均带有出厂校正,其中 4M RC 时钟还开放有用户校正寄存器,可进一步将精度校正到 $\pm 0.5\%$ 范围。64k RC 时钟在 $-40\sim 105^{\circ}\text{C}$ 范围内的精度为 $\pm 50\%$, 4M RC 时钟在该温度范围的精度为 $\pm 1\%$ 。

4M RC 时钟通过设置 RCHPD = '0'打开(默认打开,设'1'关闭),RC 时钟需要 Bandgap 电压基准源模块提供基准电压和电流,因此开启 RC 时钟需要先开启 BGP 模块。芯片上电的默认状态下,4M RC 时钟和 BGP 模块都是开启的。64k RC 时钟是始终开启的,不能关闭。

PLL 对 4M RC 时钟进行倍频,以提供给 MCU、ADC 等模块更高速的时钟。MCU 和 PWM 模块的最高时钟为 48MHz,ADC 模块典型工作时钟为 24MHz。

PLL 通过设置 PLLPDN='1'打开(默认关闭,设 1 打开),开启 PLL 模块之前,同样也需要开启 BGP(Bandgap)模块。开启 PLL 之后,PLL 需要 6us 的稳定时间来输出稳定时钟。芯片上电的默认状态下,RCH 时钟和 BGP 模块都是开启的,但 PLL 默认是关闭的,需要软件来开启。

8 基准电压源

该基准源为 ADC、DAC、RC 时钟、PLL、温度传感器、运算放大器、比较器和 FLASH 提供基准电压和电流，使用上述任何一个模块之前，都需要开启 BGP 基准电压源。

芯片上电的默认状态下，BGP 模块是开启的。基准源通过设置 BGPPD = '0' 打开，从关闭到开启，BGP 需要约 2us 达到稳定。BGP 输出电压约 1.2V，精度为±0.8%

9 ADC 模块

芯片内部集成 1 路 SAR 结构 ADC，芯片上电的默认状态下，ADC 模块是关闭的。ADC 开启前，需要先开启 BGP 和 4M RC 时钟和 PLL 模块，并选择 ADC 工作频率。默认配置下 ADC 工作时钟是 24M。

ADC 完成一次转换至少需要 17 个 ADC 时钟周期，其中 12 个为转换周期，5 个为采样周期。采样周期可通过配置 SYS_AFE_REG2 里的 SAMP_TIME 寄存器进行设置，要求设置为 3(含)以上，即 8 个 ADC clk 以上的采样时间。推荐值为 3，对应 ADC 的输出数据率 1.2MHz。

ADC 可工作在如下模式：单次单通道触发、连续单通道、单次 1~16 通道扫描、连续 1~16 通道扫描。每路 ADC 都有 16 组独立寄存器对应每一个通道。

ADC 触发事件可以来自外部的定时器信号 T0、T1、T2、T3 发生到预设次数，或者为软件触发。

ADC 带有两种增益模式，通过 SYS_AFE_REG0.GA_AD 进行设置，对应 1 倍和 2/3 倍增益。1 倍增益对应±2.4V 的输入信号，2/3 倍增益对应±3.6V 的输入信号幅度。在测量运放的输出信号时，根据运放可能输出的最大信号来选择具体的 ADC 增益。

10 运算放大器

两路输入输出 rail-to-rail 运算放大器，内置反馈电阻 $R2/R1$ ，外部引脚需串联一个电阻 $R0$ 。反馈电阻 $R2:R1$ 的阻值可通过寄存器 `RES_OPA<1:0>` 设置，以实现不同的放大倍数。具体寄存器所对应值见模拟寄存器表说明。

最终的放大倍数为 $R2/(R1+R0)$ ，其中 $R0$ 是外部电阻的阻值。

运放的两个输入引脚之间需要跨接一个电容，大于等于 15pF。

对于 MOS 管电阻直接采样的应用，建议接 $>20k\Omega$ 的外部电阻，以减小 MOS 管关断时，往芯片引脚里流入的电流。

对于小电阻采样的应用，建议接 100Ω 的外部电阻。

放大器可通过设置 `OPAOUT_EN` 选择放大器中的输出信号通过 `BUFFER` 送至 `P0.7` IO 口进行测量和应用。因为有 `BUFFER` 存在，在运放正常工作模式下也可以选择送一路运放输出信号出来。

芯片上电的默认状态下，放大器模块是关闭的。放大器可通过设置 `OPAPDN = '1'` 打开，开启放大器之前，需要先开启 `BGP` 模块。

运放输入正负端内置钳位二极管，电机相线通过一匹配电阻后直接接入输入端，从而简化了 MOSFET 电流采样的外置电路。

11 比较器

内置 2 路比较器，比较器比较速度可编程、迟滞电压可编程、信号源可编程。

比较器的比较延时为 0.15us，还可通过寄存器 CMP_FT 设置为小于 30ns。迟滞电压通过 CMP_HYS 设置为 20mV/0mV。

比较器正负两个输入端的信号来源都可通过寄存器 CMP_SELP<2:0>和 CMP_SELN<1:0>编程，详见寄存器模拟说明。

芯片上电的默认状态下，比较器模块是关闭的。比较器通过设置 CMPxPDN = '1' 打开，开启比较器之前，需要先开启 BGP 模块。

12 温度传感器

芯片内置精度为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的温度传感器。芯片出厂前会经温度校正，校正值保存在 **flash info** 区。

芯片上电的默认状态下，温度传感器模块是关闭的。开启传感器之前，需要先开启 **BGP** 模块。

温度传感器通过设置 **TMPPDN=1** 打开，开启到稳定需要约 **2us**，因此需在 **ADC** 测量传感器之前 **2us** 打开。



13 DAC 模块

芯片内置一路 8bit DAC，A 版本输出信号的量程为 3V，B 版本输出信号量程为 3V/4.8V，C 版本输出信号量程为 1.2V/3V/4.8V。

C 版本芯片，需要设置 `SYS_AFE_REG2.BIT15=1`，来使用 DAC 的 1.2V 量程。

8bit DAC 可通过配置寄存器 `DACOUT_EN=1`，将 DAC 输出送至 IO 口 P0.0，可驱动 $>50k\Omega$ 的负载电阻和 50pF 的负载电容。

由于芯片没有配备 DAC 硬件校正寄存器，为保证 DAC 输出精度，需要用户根据 DAC 量程不同从 NVR 中读取对应量程的 `DACAMC`/`DACDC` 校正值，进行软件校正。

记 DAC 期望输出值对应的数字量为 `DDAC`，增益校正值为 `DACAMC`，直流偏置校正值为 `DACDC`。其中 `DACAMC` 为 10bit 无符号数，`DACAMC[9]` 为整数部分，`DACAMC[8:0]` 为小数部分，可以表示数值在 1 附近的定点数，0x200 对应 1。设置应如下：

$$\text{SYS_AFE_DAC} = \text{Saturation}(\text{D}_{\text{DAC}} * \text{DAC}_{\text{AMC}} - \text{DAC}_{\text{DC}})$$

具体用法请参考官方库函数。

DAC 最大输出码率为 1MHz。

芯片上电的默认状态下，DAC 模块是关闭的。DAC 可通过设置 `DACPDN =1` 打开，开启 DAC 模块之前，需要先开启 BGP 模块。

14 处理器核心

- 32 位 Cortex-M0 +DIV/SQRT 协处理器
- 2 线 SWD 调试管脚
- 最高工作频率 48MHz

15 存储资源

15.1 Flash

- 内置 flash 包括 16/32kB 主存储区，1kB NVR 信息存储区
- 可反复擦除写入不低于 2 万次
- 室温 25°C数据保持长达 100 年
- 单字节编程时间最长 7.5us，Sector 擦除时间最长 5ms
- Sector 大小 512 字节，可按 Sector 擦除写入，支持运行时编程，擦写一个 Sector 的同时读取访问另一个 Sector
- Flash 数据防窃取(最后一个 word 须写入非 0xFFFFFFFF 的任意值)

15.2 Execute-only zone

部分 16kB flash 容量型号配备 16kB 只执行空间，在编程加密后具有执行权限，不具有读写权限。支持反复擦除重新编程。

15.3 SRAM

- 内置 4kB SRAM

16 电机驱动专用 MCPWM

- MCPWM 最高工作时钟频率 48MHz
- 支持最大 4 通道相位可调的互补 PWM 输出
- 每个通道死区宽度可独立配置
- 支持边沿对齐 PWM 模式
- 支持软件控制 IO 模式
- 支持 IO 极性控制功能
- 内部短路保护，避免因配置错误导致短路
- 外部短路保护，根据对外部信号的监控快速关断
- 内部产生 ADC 采样中断
- 采用加载寄存器预存定时器配置参数
- 可配置加载寄存器加载时刻和周期

17 Timer

- 2 路通用定时器，1 路 16bit 定时器，1 路 32bit 定时器
- 支持捕获模式，用于测量外部信号宽度
- 支持比较模式，用于产生边沿对齐 PWM/定时中断

18 Hall 传感器接口

- 内置最大 1024 级滤波
- 三路 Hall 信号输入
- 24 位计数器，提供溢出和捕获中断

19 通用外设

- 一路 UART，全双工工作，支持 8/9 位数据位、1/2 停止位、奇/偶/无校验模式，带 1 字节发送缓存、1 字节接收缓存，支持 Multi-drop Slave/Master 模式，波特率支持 300~115200
- 一路 SPI，支持主从模式
- 一路 IIC，支持主从模式
- 硬件看门狗，使用 RC 时钟驱动，独立于系统高速时钟，写入保护

20 特殊 IO 复用

LKS32HD303M6S8C 特殊 IO 复用注意事项

SWD 协议包含两根信号线：SWCLK 和 SWDIO。前者是时钟信号，对于芯片而言，是输入状态且不会改变输入状态。后者是数据信号，对于芯片而言，在数据传输过程中会在输入状态和输出状态间切换，默认是输入状态。

LKS32HD303M6S8C 可实现 SWD 的两个 IO 复用为其它 IO 的功能，SWCLK 复用的 IO 是 P1.8，SWDIO 复用的 IO 是 P1.9。注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件向 SYS_IO_CFG [6]写 0 开启复用。即芯片硬复位结束后，初始状态是 SWD 用途，SWD 的两个 IO 在芯片内部有上拉(芯片内部上拉电阻约为 10K)，在 IO 用作 SWD 功能时，上拉默认开启且无法关闭。当 IO 用作 GPIO 时，上拉可以通过 GPIO1_PUE[8] 和 GPIO1_PUE[9]来控制。芯片上电复位 30ms 内 P1.8 和 P1.9 固定为 SWD 功能，软件可以向 SYS_IO_CFG[6]写 0，但 IO 功能切换需要等待 30ms 后才生效。30ms 使用 LRC 计数，由于工艺原因存在一定偏差。
- 开启复用后，KEIL 等工具无法直接访问芯片，即 Debug 和擦除下载功能均失效。若需要重新下载程序，有两个方案。
 - 其一，建议使用凌鸥专用离线下载器擦除。软件开启复用的时间，建议保留一定余量，例如 100ms 左右，保证离线下载器能擦除，防止死锁。余量的多少是保证离线下载器擦除的成功率。余量越大，一次性擦除成功的概率越大。
 - 其二，程序内部有退出机制，例如某个其它 IO 电平发生变化(一般为输入)，表明外界需要用 SWDIO，软件重新配置，解除复用。此时，可以恢复 KEIL 的功能。

在 SSOP24、QFN40 和 SOP16L 的封装中，SWDIO、SWCLK 可能其他 IO bonding 在一起。此时应注意其他 IO 动作可能导致芯片误认为 SWD 动作。

SWCLK 复用的注意事项如下：

- 默认状态是不开启复用，需要软件开启复用。即芯片硬复位结束后，初始状态是 SWCLK 用途，SWDCLK 在芯片内部有上拉(芯片内部上拉电阻约为 10K)，应用对初始电平有要求的，需注意。
- 开启复用后，KEIL 等工具无法直接访问芯片，即 Debug 和擦除下载功能均失效。若需要重新下载程序，有两个方案。
 - 其一，建议使用凌鸥专用离线下载器擦除。软件开启复用的时间，建议保留一定余量，例如 100ms 左右，保证离线下载器能擦除，防止死锁。余量的多少是保证离线下载器擦除的成功率。余量越大，一次性擦除成功的概率越大。
 - 其二，程序内部有退出机制，例如某个其它 IO 电平发生变化(一般为输入)，表明外界需要用 SWCLK，软件重新配置，解除复用。此时，可以恢复 KEIL 的功能。

若此时，仅复用了 SWCLK，没有复用 SWDIO，注意事项同上。

RSTN 信号，默认是用于 LKS32HD303M6S8C 芯片的外部复位脚。

LKS32HD303M6S8C 可实现 RSTN 复用为其它 IO 的功能，复用的 IO 是 P0.2。注意事项如下：



- 默认状态是不开启复用，需要软件向 `SYS_IO_CFG[5]` 写入 1 将 RSTN 复用为普通 GPIO。即芯片初始状态是 RSTN 用途，RSTN 在芯片内部有上拉(芯片内部上拉电阻约为 100K)，应用对初始电平有要求的，需注意。
- 默认状态是 RSTN，只有 RSTN 正常释放后才能开始程序的执行，应用需要保证 RSTN 有足够保护，例如外围电路带上拉，若能加电容更佳。
- 开启复用后，RSTN 用途失效，若需产生芯片硬复位，源头只能是掉电/看门狗。
- RSTN 的复用，不影响 KEIL 的使用。

21 订购包装信息

包装类型分为 Tray 包装和 Reel 包装两种，具体包装中的芯片个数由封装形式与包装类型确定，不再以芯片型号区分。

Tray 包装信息如下表

封装形式	每盘/管数量	内盒数量	外箱数量
SOP16/ESOP16L	3000/盘	6000PCS	48000PCS
SSOP24	4000/盘	8000PCS	64000PCS
SSOP24	50/管	10000PCS	4000/100000PCS
QFN 8*8	260/盘	2600PCS	15600PCS
QFN 4*4/5*5/6*6	490/盘	4900PCS	29400PCS
QFN 3*3	5000/盘	5000PCS	40000PCS
LQFP48/TQFP48 0707	250/盘	2500PCS	15000PCS
LQFP64 1010	160/盘	1600PCS	9600PCS
LQFP100 1414	90/盘	900PCS	5400PCS
TSSOP20/28	4000/盘	8000PCS	64000PCS
QFN5*6 48L-0.75	530/盘	5300PCS	31800PCS

Reel 包装信息如下表

包装类别		每盘/管数量	每盒数量	每箱盒数	外箱数量
编带-13 寸	SOP/ESOP8	4000	8000	8	64000
编带-13 寸	SOP/ESOP16	3000	6000	8	48000
编带-13 寸	SSOP24	4000	8000	8	64000
编带-13 寸	TSSOP20	4000	8000	8	64000
编带-13 寸	D/QFN3*3	5000	10000	8	80000
编带-13 寸	D/QFN4*4	5000	10000	8	80000
编带-13 寸	D/QFN5*5	5000	10000	8	80000
管装	SOP16	50	10000	10	100000
管装	SOP14/SSOP24	50	10000	10	100000
管装	TSSOP24	54	6480	6	38880

免责声明

LKS 和 LKO 为凌鸥创芯注册商标。

南京凌鸥创芯电子有限公司（以下简称：“Linko”）尽力确保本文档内容的准确和可靠，但是保留随时更改、更正、增强、修改产品和/或 文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取最新相关信息。

客户应针对应用需求选择合适的 Linko 产品，详细设计、验证和测试您的应用，以确保满足相应标准以及任何安全、安保或其它要求。客户应对此独自承担全部责任。

Linko 在此确认未以明示或暗示方式授予 Linko 或第三方的任何知识产权许可。

Linko 产品的转售，若其条款与此处规定不同，Linko 对此类产品的任何保修承诺无效。

Linko 产品禁止用于军事用途或生命监护、维持系统。

如有更早期版本文档，一切信息以此文档为准。

